

DAN201/DAN209/DAN209S/DAN215 DAP201/DAP209/DAP209S/DAP215

エピタキシャルプレーナ形シリコンダイオードアレイ

Epitaxial Planar Silicon Diode Arrays

超高速スイッチング用/Ultra-High-Speed Switching

● 特長

- 1) 小型である。
- 2) 高信頼である。
- 3) 高速度 ($t_{rr}=1.5\text{ns}$ Typ.) である。
- 4) 組立ての自動化が可能である。

● Features

- 1) Small size.
- 2) High reliability.
- 3) High speed (t_{rr} : 1.5ns, Typ.).
- 4) Automatic assembly feasible.

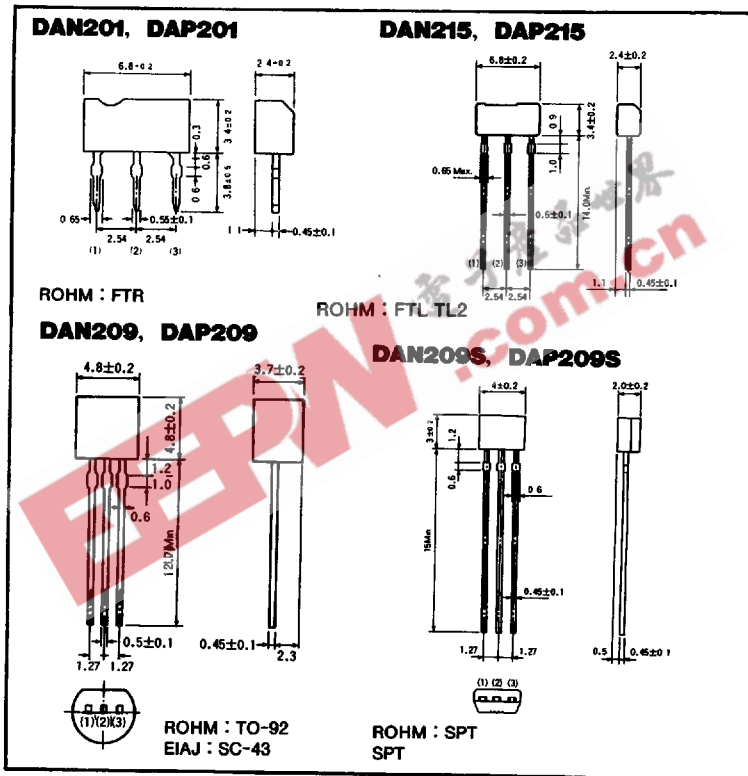
● 用途

超高速スイッチング用

● Application

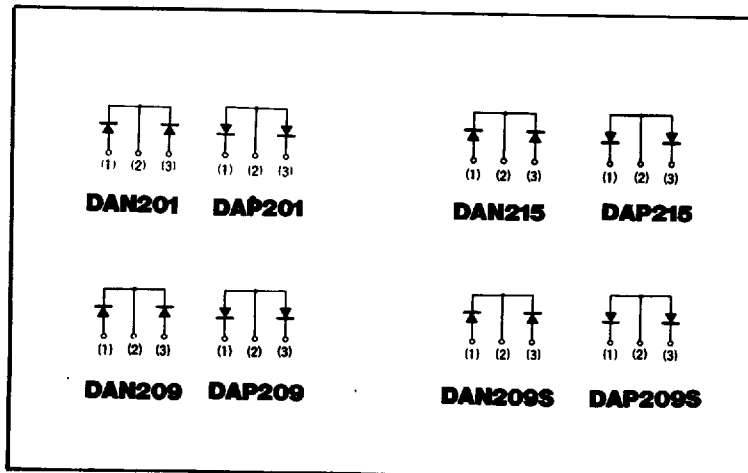
Ultra-High-Speed Switching.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



注: FTLの外形仕様については, TL3/4タイプも用意しています。

● 等価回路/Equivalent Circuits



ダイオードアレイ

整流ダイオードアレイ

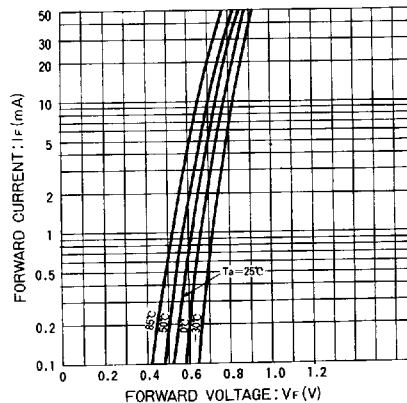
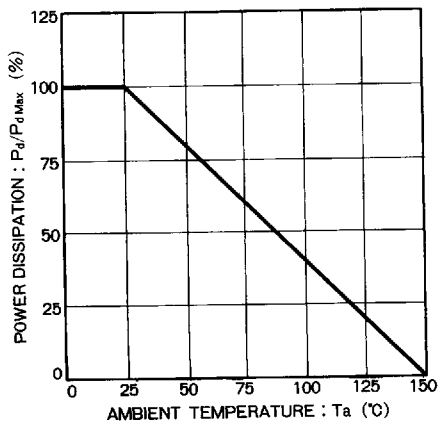
● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Type	尖頭逆電圧 VRM (V)	直流逆電圧 VR (V)	尖頭順電流 IFM (mA)	平均 整流電流 IO (mA)	サージ電流 (1 μs) Isurge (A)	許容損失 (TOTAL) Pd (mW)	接合部温度 Tj (°C)	保存温度範囲 Tstg (°C)
DAN201	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAP201	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAN209	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAP209	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAN209S	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAP209S	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAN215	80	80	300	100	4	200	150	-55~150
DAP215	80	80	300	100	4	200	150	-55~150

● 電気的特性/Electrical Characteristic (Ta=25°C)

Type	順電圧		逆電流		端子間容量			逆回復時間			
	VF (V) Max.	Cond.	IR (μA) Max.	Cond.	CT (pF) Max.	Cond.		trr (ns) Max.	Cond.		測定回路
		IF (mA)		VR (V)		VR (V)	f (MHz)		VR (V)	IF (mA)	
DAN201	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP201	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN209	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP209	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN209S	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP209S	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN215	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP215	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves (Ta=25°C)



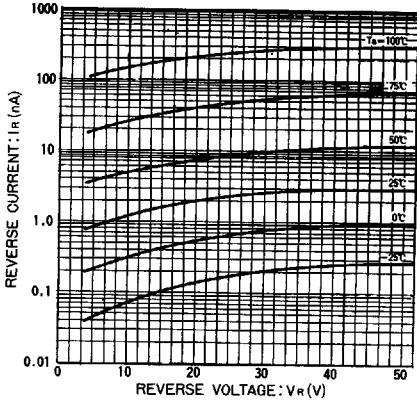


Fig.3 逆電流-逆電圧特性 (P TYPE)

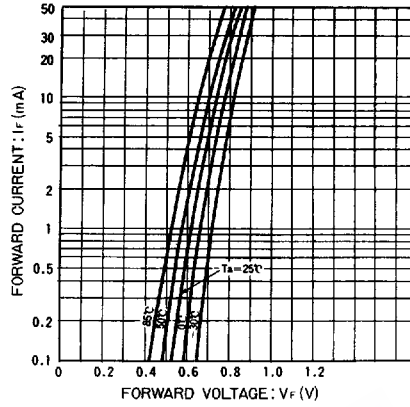


Fig.4 順電圧-順電流特性 (N TYPE)

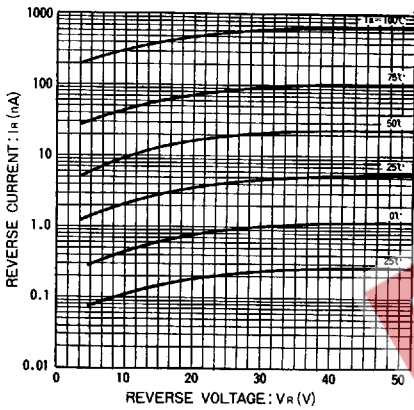


Fig.5 逆電流-逆電圧特性 (N TYPE)

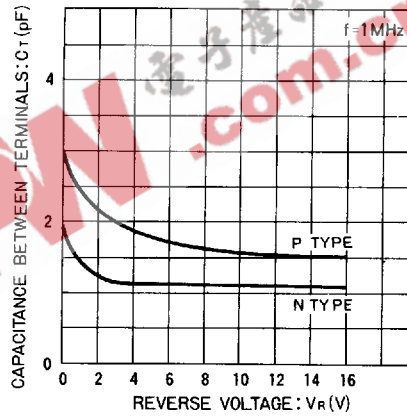


Fig.6 端子間容量-逆電圧特性

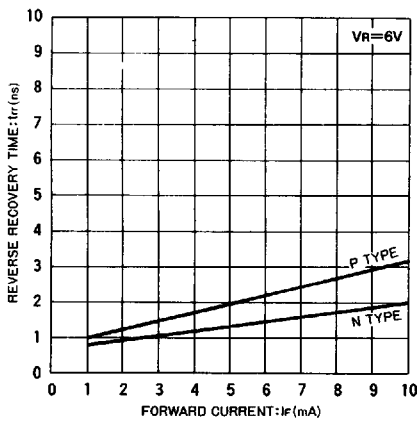


Fig.7 逆回復時間-順電流特性

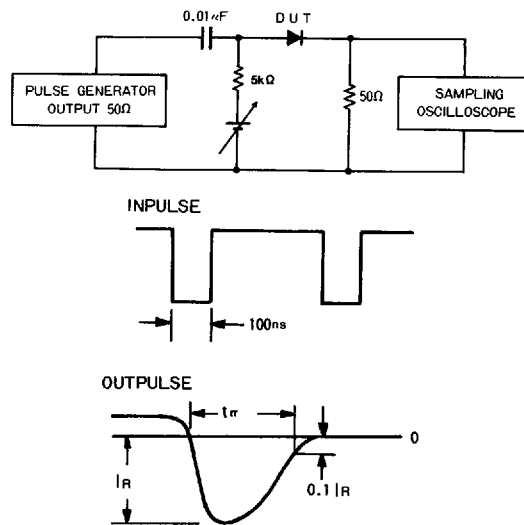


Fig.8 逆回復時間 (t_{rr}) 測定回路

ダイオードアレイ

高速度スイッチング